P-I-N 역구조 페로브스카이트 태양전지 응용을 위한 Nickel oxide 홀전달층의 열처리 온도 연구

김기성^{1,2)} · 김미정¹⁾ · 김효정³⁾ · 양정엽^{1,3)}* ¹⁾물리학과, 국립군산대학교, 군산, 54150 ²⁾플라즈마기술연구소, 한국핵융합에너지연구원, 군산, 54004 ³⁾기초과학연구소, 국립군산대학교, 군산, 54150

Annealing Temperature of Nickel Oxide Hole Transport Layer for p-i-n Inverted Perovskite Solar Cells

Gisung Kim^{1,2)} • Mijoung Kim¹⁾ • Hyojung Kim³⁾* • JungYup Yang^{1,3)}*

¹⁾Department of Physics, Kunsan National University, Gunsan, 54150, Korea ²⁾Korea Institute of Fusion Energy (KFE), Gunsan, 54004, Korea ³⁾The Institute of Basic Science, Kunsan National University, Gunsan, 54150, Korea

Received October 31, 2023; Revised November 24, 2023; Accepted November 24, 2023

ABSTRACT: A Nickel oxide (NiO_x) thin films were prepared via sol-gel process on a transparent conductive oxide glass substrate. The NiO_x thin films were spin-coated in ambient air and subsequently annealed for 30 minutes at temperatures ranging from 150°C to 450°C. The structural and optical characteristics of the NiO_x thin films annealed at various temperatures were measured using X-ray diffraction, field emission scanning electron microscopy, and ultraviolet-visible spectroscopy. After optimizing the NiO_x coating conditions, perovskite solar cells were fabricated with p-i-n inverted structure, and its photovoltaic performance was evaluated. NiO_x thin films annealed at 350°C exhibited the most favorable characteristics as a hole transport layer, resulting in the highest power conversion efficiency of 17.88 % when fabricating inverted perovskite solar cells using this film.

Key words: Sol-gel process, NiO_x thin film, p-i-n inverted perovskite solar cells, Annealing temperature, Inorganic hole transport layer

Subscript

PSCs : Perovskite solar cells PCE : power conversion efficiency ETL : electron transport layer HTL : hole transport layer XRD : x-ray diffraction FE-SEM : field emission scanning electron microscope UV-Vis : Ultraviolet-visible EQE : external quantum efficiency

1. 서 론

할라이드 페로브스카이트 태양전지(perovskite solar cells,

*Corresponding author: hyojungkim@kunsan.ac.kr (Hyojung Kim); jungyup.yang@kunsan.ac.kr (JungYup Yang) PSCs)의 전력 변환 효율(power conversion efficiency, PCE) 이 전례 없이 발전함에 따라 새로운 태양광 발전기술은 미래 태양전지 시장에서 발전단가가 낮고 유연한 태양전지를 제공 할 가능성이 매우 높아졌다¹⁻³⁾. 일반적으로 할라이드 PSCs은 n-type 전자 전달층(electron transport layer, ETL), p-type 정공 전달층(hole transport layer, HTL) 사이에 있는 페로브스카이트 광 흡수층으로 구성된다. 태양전지에 빛이 들어오면 할라이 드 페로브스카이트 층에서 생성된 exciton이 분리되어 전자는 ETL을 통해 정공은 HTL을 통해 외부 전극으로 운반된다. 이 러한 소자의 성능은 할라이드 페로브스카이트 흡수층의 화학 량론(stoichiometry)과 ETL, HTL의 구성⁴⁻⁷⁾ 및 소자 형태에 따 라 크게 좌우된다. 페로브스카이트 활성층의 제작은 저비용 용 액공정을 통하여 얻을 수 있는 반면에, HTL과 ETL의 제작은 진 공공정이나 원가가 높은 소재가 많이 사용된다. 특히 HTL은 지 금까지 유기물 기반 소재가 많이 알려져 있고, 원가 또한 ETL보 다 더 높은 소재를 이용하고 있다^{8,9}. 게다가 유기물 기반의 HTL

© 2023 by Korea Photovoltaic Society

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0)

which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

소재는 PSCs의 PCE를 향상시키는데 큰 역할을 하였으나, 환경 조건에 대한 민감성으로 인해 안정성 측면에서 상당한 제한이 있다. 따라서 효율적이고 안정적일 뿐만 아니라 실행 가능한 확 장성을 제공하고 전반적인 제조 비용을 줄이기 위해 다른 HTL 소재를 시급하게 탐색해야 한다. PSCs에 활용할 수 있는 HTL 무기물 소재 중 NiO_x는 안정성이 우수한 산화물 반도체 특성을 가지며, 높은 정공 이동성, 넓은 에너지 밴드갭(energy band gap, 3.5 eV~4.0 eV), 우수한 광학적 투명성, 우수한 열 및 화학 적 안정성 및 용액공정 코팅방식 등으로 PSCs에 활용할 많은 가 능성을 보여주는 후보 소재이다^{10,11}.

본 연구에서는 역구조(inverted structure) 페로브스카이트 태양전지 소자의 HTL 응용을 위하여 무기물 기반 NiO_x 박막에 대한 연구를 수행하였다. NiO_x 박막은 sol-gel 공정을 이용하여 indium tin oxide (ITO) glass 위에 코팅하였고, 열처리 온도에 따 라 NiO_x 박막의 특성 변화를 살펴보기 위하여 구조적, 광학적 분 석을 수행하였다. 그 결과 350°C 열처리 된 NiO_x 박막이 가장 우 수한 HTL 특성을 보였고, 17.88% PCE를 가지는 역구조 페로브 스카이트 태양전지를 얻을 수 있었다.

2. 실험방법

2.1 페로브스카이트 태양전지 제조방법

ITO 패턴 기판(15Ω/sq)을 계면활성제인 2 vol% 희석된 Hellmanex로 희석한 증류수(DI water)로 세정 후 아세톤(Acetone), 에탄올(Ethyl alcohol) 및 isopropanol (IPA)을 이용하여 순차적 으로 30분간 초음파세척기로 세척한 다음 N2 가스를 불어 건조 하였다. 이어서, 유기 잔류물을 제거하기 위해 30분간 자외선 오 존 표면처리를 하여 기판을 준비하였다. HTL은 sol-gel법을 이 용하여 NiOx 층을 코팅하였다. Sol-gel 코팅을 위한 용액은 nickel (II) acetate tetrahydrate에 1 mL의 에탄올을 넣어 0.05 M 의 농도로 용해시킨 후 ethanolamine 0.6 vol%를 첨가하여 50°C 에서 교반하여 준비하였다. 세척된 ITO 기판에 교반된 sol-gel NiOx 용액을 3000 rpm에서 40초 동안 스핀 코팅 후 150°C, 250°C, 350°C, 450°C에서 30분간 열처리를 수행하였다. 페로 브스카이트층의 전구체 용액은 CsI 66 mg, FAI 187 mg, MABr 12.2 mg, PbI₂ 568 mg, PbBr₂ 79.8 mg, dimethyl sulfoxide (DMSO) 용액 220 mg에 dimethylformamide (DMF) 용액을 755 mg을 넣고 실온에서 1시간 동안 교반하면서 혼합하였다. 페 로브스카이트광 활성층 형성은 교반된 전구체 용액을 NiOx 층 위에 500 rpm에서 5초, 5000 rpm에서 45초 동안 스핀 코팅하고 회전하는 기판에 박막의 핵 및 grain 크기 성장을 위해 0.3 mL의 chlorobenzene을 15초에 적하하는 반-용매 공정(Anti-solvent process)을 이용하였다. 코팅 후 hot plate를 이용하여 100°C에 서 45분 동안 열처리하여 고품질의 조밀한 Cs0.17(FA0.91MA0.09)0.83 Pb(I,Br)3 (CFM) 페로브스카이트 박막을 얻었다. 전자 전달층인 C₆₀ (Fullerene) 층은 CFM 페로브스카이트 코팅 후 evaporation chamber에 넣고 고진공(2×10^{-7} Torr) 조건에서 열 증착 방식으 로 증착하였다^{12,13}. Thickness monitor를 이용하여 전류를 조절 하여 0.5 Å/sec의 속도로 15 nm의 두께를 증착하였다. Buffer layer인 Bathocuproine (BCP)는 에탄을 6 ml에 BCP 분말 6 mg 을 희석시켜 70°C에서 12시간 교반하였다. C₆₀ 층위에 BCP 용 액을 4000 rpm에서 30초 동안 스핀 코팅 후 N₂ 분위기의 상온에 서 건조하였다. BCP 층은 ETL/Electrode의 계면의 전하 축적을 제거하여 p-i-n 구조의 페로브스카이트 태양전지의 효율 향상을 위해 사용되었다. 마지막으로 Ag 전극을 evaporation chamber 에 넣고 고진공(2×10^{-7} Torr) 조건에서 thickness monitor를 이 용하고 전류를 조절하여 0.3 Å/sec의 속도로 10 nm 증착 후 1.0 Å/sec로 90 nm를 증착하여 총 100 nm를 열 증착하였다.

2.2 특성 분석

NiO_x HTL 소재를 분석하기 위하여 열처리 온도에 따라 X-선 회절(X-ray diffraction, XRD) 장치를 이용하여 결정성 변화를 관측하였으며, 자외선 가시 분광 광도계(UV-Vis spectroscopy, UV-Vis)로 투과율 및 흡수율을 측정하였다. NiO_x 단면 및 역구 조 페로브스카이트 PSCs 소자의 단면 형상 측정은 전계 방출주 사 전자 현미경(Field Emission Scanning Electron Microscope, FE-SEM)을 이용하여 관측하였다. 역구조 할라이즈 페로브스 카이트 태양전지 소자 특성을 분석하기 위하여 Keithley 4200S-SCS가 장착된 class AAA 태양광 시뮬레이터를(150 W Xenon 램프) 사용하여 AM 1.5G 태양 광원(100 mW/cm²)을 조사하여 전류밀도-전압 곡선(*J-V* curve)을 얻었다. 또한 외부 양자 효율 (external quantum efficiency, EQE) 측정을 통해 각 파장별로 소 자의 특성을 확인하였다.

3. 결과 및 고찰

Fig. 1은NiOx 기반의 p-i-n 역구조 PSCs 단면 개략도와 이에



Fig. 1 Schematic, energy band diagrams, and cross-sectional SEM image of inverted perovskite solar cells

따른 band alignment 및 소자 단면 SEM 사진을 보여준다. ITO 투명전극은 거칠기가 완만하여 기판 위에 얇은 두께의 박막 균 일하게 코팅하기 쉬운 장점이 있어 NiO_x는 sol-gel 방법을 이용 하여 약 15 nm의 얇은 두께로 코팅하였다. 페로브스카이트 광 활성층은 MAPbI₃의 안정성 문제로 A site에 Cs⁺, FA⁺, MA⁺ 양 이온, X site에 Γ , Br⁻ 할로겐 음이온을 적정량 대체한 삼중 양 이온 CFM 페로브스카이트 소재를 사용하였다. ETL로 C₆₀을 evaporation을 통해 두께 조건을 조절하여 균일한 박막으로 증 착하였다. CFM 페로브스카이트층에서 Γ 이온의 이동으로 AgI 형성을 막기 위해 C₆₀과 Ag 사이에 buffer layer로 BCP가 사용되 었다. AgI 형성은 전자를 빼내는 통로인 전극의 저항이 높아지 고 Γ 이온의 이동으로 인한 페로브스카이트 층의 분해로 볼 수 있어서 PSCs에서 좋지 않은 영향을 미친다¹⁴.

Fig. 2는 NiO_x 박막의 열처리 온도에 따른 XRD 측정 결과이 다. Fig. 2를 보면 sol-gel법을 이용하여 박막 코팅 후 150°C ~ 450°C의 열처리를 하였으나 모든 온도에서 결정성이 비정질 (amorphous)로 나온 것을 확인하였다. 이는 sol-gel법으로 코팅 한 NiO_x 박막은 450°C, 30분의 열처리 조건 이하에서는 결정화 되지 않는 다는 것을 알 수 있다. 비정질 NiO_x HTL은 전류이동 이 빠르게 잘 통해서 페로브스카이트 태양전지에 유리하게 작 용하는 것으로 알려져 있다¹⁵.

Fig. 3은 sol-gel법으로 bare glass 위에 코팅한 NiO_x 박막의 투과율 및 흡수율로 계산한 tau-plot 결과이다. Fig. 3 (a)를 보면 NiO_x 박막의 경우 열처리 온도가 높아짐에 따라 투과율이 약간



Fig. 5는 높은 열처리로 인하여 ITO 기판으로부터 In 물질 이 NiO_x 층으로 확산한 것을 정확하게 관측하기 위하여 x-ray photoelectron spectroscopy (XPS)를 측정한 결과이다. 그림에 서 보는 것 같이 열처리 온도에 따른 NiO_x 박막의 In 3d peak을 관측한 결과 In 물질의 NiO_x 박막으로의 확산은 250°C부터 시 작하며 열처리 온도가 올라가면 In 확산은 더 많이 일어나는 것



Fig. 4 Tau-plot of NiO_x thin films on ITO glass annealed at different temperature



Fig. 3 UV-Vis transmittance spectra and tau-plot of NiO_x thin films with different annealing temperature

Fig. 5 XPS In 3d spectra of NiO_x thin film on ITO glass annealed at different temperature



Fig. 2 XRD patterns of NiO_x thin film fabricated with different annealing temperature

(b)

(ahv)²(eVcm⁻¹)²

250 °C 350 °C 450 °C

Bare glass/NiO>

Bare glass/NiOx

Bandgap : 3.9e

3.5

Energy (eV)

(a)

Transmittance (%)

60 40

20

0 L 300 500 600 700 800

Wavelength (nm)

400

을 알 수 있다. 특히 450°C 결과를 보면 In peak가 강하게 나타나 는 것으로 봐서 In 물질이 상당량 NiOx 층으로 확산한 것을 알 수 있었다.

Fig. 6은 열처리 온도별로 제작한 NiOx HTL을 이용하여 할라 이드 PSCs을 제작하여 current density-voltage (J-V) 특성을 측 정한 결과이며, Table 1은 소자 특성 결과를 요약한 것이다. 그림 에서 보는 것처럼 150°C 열처리 온도는 잔류 용매가 남아 있고 NiOx 박막의 형성이 제대로 이루어지지 않아 소자 특성이 전혀 관측되지 않았다. 250°C에서도 낮은 열처리 온도로 저품질의 NiOx 박막이 형성되어 HTL 역할을 수행하지 못해 낮은 개방전 입(open-circuit voltage, Voc), 단락전류밀도(short-circuit current density, J_{SC}), 충진률(fill factor, FF), PCE 특성을 보인 것으로 생각된다. 그러나 350°C로 열처리한 NiOx 박막은 HTL로써 역 할을 제대로 수행할 수 있는 고품질의 박막이 형성되어 소자 특 성 또한 가장 우수한 0.981V의 개방전압, 22.63 mA/cm²의 단 락전류, 80.5%의 충진률과 17.88%의 변환 효율을 확인하였 다. 450°C 열처리한 NiOx 박막의 경우 앞서 분석한 예상대로 높 은 열처리로 인한 ITO 기판에서 In의 확산으로 인하여 NiOx 투 과율 감소와 ITO 저항의 증가로 단락전류밀도 및 충진률 성능이 감소하였다.

Fig. 7은 최고 성능을 보인 350 °C에서 열처리한 NiO_x HTL을 이용한 역구조 PSCs의 외부양자효율(external quantum efficiency, EQE)을 측정한 결과 및 이를 이용하여 계산된 integrated J_{sc} 값 이다. EQE 곡선은 전형적인 NiO_x 역구조 PSCs의 형태로 관측 되었고, 계산된 integraed J_{sc} 는 약 20.12 mA/cm²가 관측되었다.



Fig. 6 *J-V* curve of inverted perovskite solar cells according to the NiO_x annealing temperature

 Table 1 Photovoltaic device parameters with different annealing temperature of NiO_x HTL

Annealing temperature (°C)	V _{oc}	J _{SC} (mA/cm ²)	FF (%)	PCE (%)
150	0.118	0.17	0	0
250	0.891	14.73	48.4	6.36
350	0.981	22.63	80.5	17.88
450	0.962	21.65	69.2	14.40



Fig. 7 EQE and integrated J_{SC} calculated by EQE curve of inverted perovskite solar cells prepared by NiO_x HTL annealed at 350°C and 30 min

4. 결 론

페로브스카이트 태양전지는 2009년 연구개발이 시작된 이 래로 2023년까지 26.1%의 빠른 효율 성장력을 보이는 차세대 태양전지로 주목받았다. 하지만 비싼 재료의 원가 측면에서 문 제와 수분, 산소, 열 등에 의한 열화로 인해 상용화에 어려움을 느끼고 있다. 본 연구에서 고가 및 안정성에 약점이 있는 유기물 기반의 HTL 소재의 사용을 대체하기 위하여 무기물 기반의 저 가 NiOx HTL 소재를 적용하기 위한 연구를 수행하였다. NiOx 는 sol-gel 방법으로 제작하였고, 박막의 코팅 후 열처리 온도에 따른 특성을 분석한 결과 350°C로 열처리한 경우 최적의 NiOx HTL 성능 및 PSCs 소자 성능을 관측할 수 있었다. 또한 350℃ 미만의 열처리 온도에서는 저품질의 NiOx 박막이 관측되었고, 450°C 열처리 온도에서부터 ITO 기판으로부터 NiOx 박막으로 In이 확산되어 NiOx HTL 특성 저하 및 PSCs 특성 저하가 나타 나는 것을 관측하였다. 결과적으로 sol-gel 공정에서 NiOx 박막 의 350°C 열처리 조건이 가장 좋은 성능을 보였고, 이를 PSCs에 적용한 결과 17.88% PCE를 달성하였다. 본연구에서는 sol-gel 공정을 이용한 NiOx 박막은 p-i-n 역구조 PSCs 적합한 특성을 가진 무기 HTL로써 충분히 가능성이 크다는 것을 확인할 수 있 었다.

후 기

이 논문은 2023년도 정부(과학기술정보통신부) 출연 재원으 로 한국핵융합에너지연구원 "플라즈마 융합원천 연구사업"의 지원을 받아 수행된 연구임(EN2321-11). 본 연구는 IDEC에서 EDA Tool를 지원받아 수행하였습니다. 본 성과물은 중소벤처 기업부에서 지원하는 2022년도 창업성장기술개발사업 전략형 (그린뉴딜, S2798421) 의 연구수행으로 인한 결과물임을 밝힙 니다.

References

- Bai, Y., Meng, X., and Yang, S., "Interface Engineering for Highly Efficient and Stable Planar p-i-n Perovskite Solar Cells," Advanced Energy Materials., 8, 1701883 (2017).
- Yao, D., Zhang, C., Zhang, S., Yang, Y., Du, A., Waclawik, E. R., Yu, X., Wilson, G. J., and Wang, H., "2D-3D Mixed Organic-Inorganic Perovskite Layers for Solar Cells with Enhanced Efficiency and Stability Induced by *n*-Propylammonium Iodide Additives," ACS Appl. Mater. Interfaces, 11, 33, 29753-29764 (2019).
- Pham, N. D., Zhang, C., Tiong, V. T., Zhang, S., Will, G., Bou, A., Bisquert, J., Shaw, P. E., Du, A., and Wilson, G. J., "Tailoring Crystal Structure of FA_{0.83}Cs_{0.17}PbI₃ Perovskite Through Guanidinium Doping for Enhanced Performance and Tunable Hysteresis of Planar Perovskite Solar Cells," Adv. Funct. Mater., 29, 1806479 (2019).
- Saliba, M., Matsui, T., Seo, J.-Y., Domanski, K., Correa-Baena, J.-P., Nazeeruddin, M. K., Zakeeruddin, S. M., Tress, W., Abate, A., Hagfeldt, A., and Grätzel, M., "Cesium-containing triple cation perovskite solar cells: improved stability, reproducibility and high efficiency," Energy Environ. Sci., 9, 1989 (2016).
- Yang, W. S., Park, B.-W., Jung, E. H., Jeon, N. J., Kim, Y. C., Lee, D. U., Shin, S. S., Seo, J., Kim, E. K., Noh, J. H., and Seok, S. I., "Iodide management in formamidinium-leadhalide-based perovskite layers for efficient solar cells," Science, 356, 1376 (2017).
- Gedamu, D., Asuo, I. M., Benetti, D., Basti, M., Ka, I., Cloutier, S. G., Rosei, F., and Nechache, R., "Solvent-Antisolvent Ambient Processed Large Grain Size Perovskite Thin Films for High-Performance Solar Cells," Sci. Rep., 8, 12885 (2018).
- Snaith, H. J., "Perovskites: The Emergence of a New Era for Low-Cost, High-Efficiency Solar Cells," J. Phys. Chem. Lett, 4, 3623 (2013).
- Chen, W.-Y., Deng, L.-L., Dai, S.-M., Wang, X., Tian, C.-B., Zhan, X.-X., Xie, S.-Y., Huang, R.-B., and Zheng, L.-S., "Lowcost solution-processed copper iodide as an alternative to PEDOT:PSS hole transport layer for efficient and stable

inverted planar heterojunction perovskite solar cells," J. Mater. Chem. A., 3, 19353 (2015).

- Qiu, L., Ono, L. K., and Qi, Y., "Advances and challenges to the commercialization of organic-inorganic halide perovskite solar cell technology," Mater. Today Energy, 7, 169 (2018).
- Md. Bodiul Islam, Masatoshi Yanagida, Yasuhiro Shirai, Orcid, Yoichi Nabetani, and Kenjiro Miyano, "NiOx Hole Transport Layer for Perovskite Solar Cells with Improved Stability and Reproducibility," ACS Omega, 2, 2291 (2017).
- X. Cai a, T. Hu a, H. Hou, P. Zhu, R. Liu, J. Peng, W. Luo, and H. Yu, "A review for nickel oxide hole transport layer and its application in halide perovskite solar cells," Mater. Today Sustainability, 23, 100438 (2023).
- Xu, Z., Wu, J., Wu, T., Bao, Q., He, X., Lan, Z., Lin, J., Huang, M., Huang, Y., and Fan, L., "Tuning the Fermi Level of TiO₂ Electron Transport Layer through Europium Doping for Highly Efficient Perovskite Solar Cells," Energy technology, 5, 1820-1826 (2017).
- Choi, D. H., Seok, H.-J., Kim, D.-H., Kim, S.-K., and Kim, H.-K., "Thermally-evaporated C₆₀/Ag/C₆₀ multilayer electrodes for semi-transparent perovskite photovoltaics and thin film heaters," Sci Technol Adv Mater, 21, 435-449 (2020).
- Saeid Asgary, Hossain Milani Moghaddam, Ali Bahari, and Raheleh Mohammadpour, "Role of BCP layer on nonlinear properties of perovskite solar cell," Solar Energy, 213, 383 (2021)
- Jiménez-González, A. E. and Cambray, J. G., "Deposition of NiOx thin films by sol-gel technique, Surface Engineering, 16, 73-76 (2000).
- Li, F., Chen, C., Tan, F., Li, C., Yue, G., Shen, L., and Zhang, W., "Semitransparent inverted polymer solar cells employing a sol-gel-derived TiO₂ electron-selective layer on FTO and MoO₃/Ag/MoO₃ transparent electrode," Nanoscale Res. Lett., 9, 579 (2014).
- Kim, J. H., Kim, M. H., Kim, H. J., and Yang, J. Y., "TiO₂ thin film deposition by RF reactive sputtering for n-i-p planar structured perovskite solar cells," Appl. SciConverg. Technol., 31 (5), 116-119 (2022).